

**Отделения нанотехнологий и информационных технологий  
Российской академии наук  
Научный совет РАН «Фундаментальные проблемы элементной базы  
информационно-вычислительных и управляющих систем и материалов для ее  
создания».**

**Консорциум «Перспективные материалы и элементная база информационных  
и вычислительных систем»**

---

**Программа научного семинара «Топологически нетривиальные материалы:  
двумерные и трёхмерные топологические изоляторы»**

(АО «НИИМЭ», 4 апреля 2018 г. в 11:00)

- 11:00 *Академик РАН Г.Я. Красников* (АО «НИИМЭ») – открытие научного семинара
- 11:10 *Докт. физ.-мат. наук О.Е. Терещенко* (ИФП СО РАН), *канд. геол.-минерал. наук К.А. Кох* (ИГМ СО РАН), *В.А. Голяшов* (ИФП СО РАН), *докт. физ.-мат. наук А.М. Шикин* (СПбГУ) «Электронная и спиновая структура топологических изоляторов и графеноподобных систем»
- 11:40 *Докт. физ.-мат. наук В.А. Волков* (ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН) «Поверхностные состояния дираковских и вейлевских фермионов»
- 12:10 *Докт. физ.-мат. наук С.А. Тарасенко* (ФТИ им. А.В. Иоффе) «Двумерные и трехмерные топологические изоляторы на основе HgTe»
- 12:40 *Докт. физ.-мат. наук Э.В. Девятов* (ИФТТ РАН) «Исследование топологических поверхностных состояний при помощи сверхпроводящих контактов»
- 13:10 Кофе-брейк
- 13:40 *Докт. физ.-мат. наук Д.Х. Квон* (ИФП СО РАН) «Топологические изоляторы на основе HgTe»
- 14:10 *Канд. физ.-мат. наук С.И. Божко* (ИФТТ РАН) «СТМ/СТС поверхностных состояний топологических изоляторов»
- 14:40 *Член-корр. РАН Д.Р. Хохлов* (МГУ) «Фотогальванические эффекты в двумерных и трёхмерных топологических изоляторах» (список соавторов и тема уточняется)
- 15:10 Подведение итогов научного семинара